
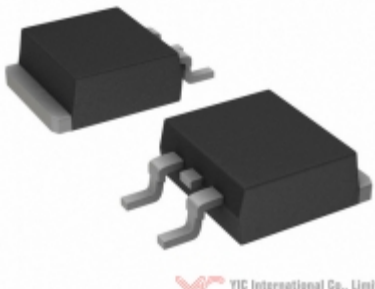
	<h2 style="color: red;">FQB19N20LTM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQB19N20LTM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB19N20LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 49405 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB19N20LTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	49405 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®











FQB19N20LTM ist neu im Original, Suche FQB19N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB19N20LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB19N20LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB19N20 F FQB19N20 F</p>	 <p>FQB19N20L F FQB19N20L F</p>	 <p>FQB19N20CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A D2PAK</p>	 <p>FQB19N20CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A D2PAK</p>
 <p>FQB19N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p>	 <p>FQB1N60 FAIRCHILD FQB1N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB19N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK</p>	 <p>FQB19N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB13N10	 FQB13N10L	 FQB13N50	 FQB13N50CTM	 FQB13N50CTM
 FQB140N03L	 FQB14N30TM	 FQB14N30TM	 FQB16N25TM	 FQB16N25TM
 FQB17P06	 FQB17P10	 FQB17P10TM	 FQB17P10TM	 FQB19N10L
 FQB19N10LTM	 FQB19N10LTM	 FQB19N10TM	 FQB19N10TM	 FQB19N20
 FQB19N20C	 FQB19N20CTM	 FQB19N20CTM	 FQB19N20L	 FQB19N20LTM
 FQB19N20TM	 FQB19N20TM	 FQB1N60TM	 FQB1N60TM	 FQB20N06L
 FQB20N60FTM	 FQB20N60TM	 FQB22P10	 FQB22P10TM	 FQB22P10TM
 FQB22P10TM_F085	 FQB24N08TM	 FQB24N08TM	 FQB25N33	 FQB25N33TM
 FQB25N33TM	 FQB25N33TM_F085	 FQB27N25TM	 FQB27P06	 FQB27P06TM
 FQB27P06TM	 FQB2N50C	 FQB2N60TM	 FQB2N60TM	 FQB2N80TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited